УДК 544.6, 546.161, 548.55, 548.73

# ВЫРАЩИВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ $Sm_{1-v}Sr_vF_{3-v}$ (0 < $y \le 0.31$ )

© 2019 г. Н. И. Сорокин<sup>1</sup>, Д. Н. Каримов<sup>1,\*</sup>, Н. В. Самсонова<sup>1</sup>, А. Г. Иванова<sup>1</sup>, В. А. Федоров<sup>1</sup>, Б. П. Соболев<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт кристаллографии им. А.И. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия \* E-mail: dnkarimov@gmail.com

Поступила в редакцию 26.02.2018 г. После доработки 26.03.2018 г. Принята к публикации 23.04.2018 г.

Из расплава методом направленной кристаллизации во фторирующей атмосфере получены кристаллы  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  (0 <  $y \le 0.31$ ). Кристаллы изучены методами рентгенофазового анализа и оптической спектроскопии, измерены их фтор-ионная проводимость  $\sigma_{dc}$ , плотность  $\rho$  и показатели преломления  $n_D$ . Установлено, что в условиях роста кристаллов не происходит восстановления ионов  $Sm^{3+}$  до  $Sm^{2+}$ . Обратимый полиморфный переход  $\alpha \leftrightarrow \beta$ -SmF<sub>3</sub> не позволяет получить объемные (>1–3 мм<sup>3</sup>) образцы тисонитовой фазы (тип LaF<sub>3</sub>) при y < 0.02. Зависимости  $\rho(y)$  и  $n_D(y)$  кристаллов носят убывающий характер. Зависимость  $\sigma_{dc}(y)$  имеет немонотонный вид, максимальной  $\sigma_{dc} = 1.6 \times 10^{-4}$  См/см при 293 К обладает кристалл  $Sm_{0.98}Sr_{0.02}F_{2.98}$ . При y = 0.31 образуется эвтектический композит 69SmF<sub>3</sub> × 31SrF<sub>2</sub>, проводимость которого  $\sigma_{dc} = 6 \times 10^{-8}$  См/см, что ниже  $\sigma_{dc}$  кристалла с y = 0.02 в ~3 × 10<sup>3</sup> раз. В рамках модели прыжковой проводимости рассчитаны концентрация  $n_{mob}$  и подвижность  $\mu_{mob}$  носителей заряда для  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  (0.02 ≤  $y \le 0.25$ ). Для наиболее проводящего кристалла  $Sm_{0.98}Sr_{0.02}F_{2.98}$   $n_{mob} = 4.0 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> и  $\mu_{mob} = 2.5 \times 10^{-6}$  см<sup>2</sup>/Вс при T = 293 К.

DOI: 10.1134/S0023476119030263

# введение

Выращиваемые из расплава в графитовых контейнерах кристаллы на основе фторидов редкоземельных элементов (**P3**Э) с переменной степенью окисления, к которым относятся самарий, европий и иттербий, подвержены частичному восстановлению (Sm<sup>3+</sup>  $\rightarrow$  Sm<sup>2+</sup>, Eu<sup>3+</sup>  $\rightarrow$  Eu<sup>2+</sup>, Yb<sup>3+</sup>  $\rightarrow$  Yb<sup>2+</sup>), степень которого трудно контролировать. В результате данные о высокотемпературной химии трифторидов РЗЭ, склонных к образованию нетипичной степени окисления  $R^{2+}$ , отстают от состояния изученности химии трифторидов других РЗЭ, поскольку всегда оставался неясным вопрос о химическом составе таких кристаллов.

Нестехиометрические тисонитовые (тип LaF<sub>3</sub>) фазы Sm<sub>1-y</sub> $M_y$ F<sub>3-y</sub> на основе SmF<sub>3</sub> представляют интерес как фторпроводящие твердые электролиты (**ФТЭЛ**), нарушения стехиометрии которых достигаются гетеровалентными изоморфными замещениями Sm<sup>3+</sup> на  $M^{2+}$  (M =Ca, Sr, Ba). При низкой степени восстановления Sm<sup>3+</sup> такие кристаллы можно рассматривать как псевдобинарные. Исходя из данных о частичном восстановлении расплава  $SmF_3$  графитом [1], исследователи старались ограничивать опыты по росту кристаллов фторидов с его участием в качестве компонента. В результате для  $SmF_3$  (и в меньшей степени для  $EuF_3$  и  $YbF_3$ ) возник пробел как в области знаний о его высокотемпературной химии, так и о возможностях получения и использования материалов с его участием. С этим ограничением на исследования Sm-содержащих фторидных кристаллов в ряде областей применения (особенно, фотонике) приходилось мириться.

Для предпринятой в работе оптимизации составов сильно нестехиометрических ФТЭЛ по величине ионной проводимости высокая чистота кристаллов по примесям не так критична, что подтолкнуло поставить эксперименты по росту нестехиометрических кристаллов на основе SmF<sub>3</sub>. Ранее [2, 3] были изучены ионопроводящие свойства кристалла состава Sm<sub>0.875</sub>Sr<sub>0.125</sub>F<sub>2.875</sub>, которые показали его высокие электролитические характеристики. Тисонитовая фаза Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> представляет интерес как ФТЭЛ и по своим свойствам сопоставима с известными высокопроводящими твердыми электролитами  $R_{1-y}$ Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (R = La-Nd) [4-6].

Выполнение этого исследования помимо прикладной задачи оптимизации ФТЭЛ для нового поколения источников тока имеет большое значение для развития высокотемпературной химии фторидов РЗЭ переменной валентности и фторидного материаловедения.

Химическое семейство РЗЭ является самым многочисленным (17 элементов) во всей Периодической системе элементов. Оно характеризуется большим изменением размеров ионов  $R^{3+}$  по ряду РЗЭ. Эти изменения немонотонно меняются с ростом атомного номера: растут от  $Sc^{3+}$  к  $Y^{3+}$ и далее до La<sup>3+</sup>, затем начинают уменьшаться до Lu<sup>3+</sup> (эффект лантаноидного сжатия). На фоне изменений ионных радиусов происходит три смены структурных типов соединений RF<sub>3</sub> (морфотропные превращения), разбивающие ряд трифторидов РЗЭ на пять структурных подгрупп. От типа структур, наличия (отсутствия) полиморфных превращений у соединений этих подгрупп и температур фазовых переходов зависит корректность фазовых диаграмм с участием  $RF_3$ , на которых базируется фторидное материаловедение с участием ионов РЗЭ, важных для практических применений во многих областях физики.

Первый морфотропный переход в ряду  $RF_3$  приходится на участок ряда, охватывающий элементы Pm, Sm, Eu. Оказалось, что фториды всех этих трех РЗЭ ограничены для экспериментальных исследований. Фторид прометия недоступен из-за естественной радиоактивности, фториды самария и европия почти не получали для практического применения из-за частичного восстановления. В результате три РЗЭ подряд выпали из ряда, предельно затруднив интерполяцию свойств соединений Pm, Sm, Eu, которая хорошо работает как прием именно для РЗЭ на малых участках ряда.

В условиях, обычных для термического анализа скоростей нагрева в номинально чистом SmF<sub>3</sub>, происходит обратимый фазовый переход из непроводящей ромбической β-формы (пр. гр. *Pnma*, Z = 4) в низкотемпературную фтор-проводящую тисонитовую форму  $\alpha$ -*l*-SmF<sub>3</sub> (пр. гр. *P*3*c*1, Z = 6).

Отметим, что структура типа тисонита имеет две формы: тригональную (пр. гр.  $P\overline{3}c1$ , Z = 6) и гексагональную (пр. гр.  $P6_3/mmc$ , Z = 2), которые выделены в [7] и по этим данным соотносятся как высокотемпературная и низкотемпературная соответственно. Переход между ними может быть отнесен к типу "размытого", затрагивающего только одну из подрешеток – анионную. Аналогичный переход наблюдается у соединений со структурой типа флюорита и не является реконструктивным полиморфным превращением. Для того чтобы отделить "размытый" переход (между формами) от полиморфного (между модификациями) решено сохранить за модификациями общепринятые обозначения буквами греческого алфавита ( $\alpha$ ,  $\beta$ ). Разные типы тисонитовой (в данном случае) структуры обозначим в соответствии с областью их температурной устойчивости как *h*- (*high* – высокотемпературная) и *l*- (*low* – низкотемпературная) формы. Они незначительно различаются на рентгенограммах порошка, не всегда определяются в работах и могут сосуществовать в одном кристалле. Когда эти формы определены (как в данной работе), возникают двойные обозначения, включающие в себя модификацию и форму.

Учитывая сказанное выше, тисонитовая модификация α-SmF3 в свою очередь претерпевает "размытый" переход из низкотемпературной формы  $\alpha$ -*l*-SmF<sub>3</sub> (пр. гр.  $P\overline{3}c1, Z=6$ ) в высокотемпературную форму  $\alpha$ -*h*-SmF<sub>3</sub> (пр. гр. *P*6<sub>3</sub>/*mmc*, *Z*= = 2) при T ~ 1100°С [8]. Из двух РЗЭ (Sm, Eu) полиморфный переход у EuF<sub>3</sub> происходит при 852 ±  $\pm$  8°C [7], т.е. в области температур, где расторможена объемная диффузия, и его наличие хорошо доказывается термическим анализом. У SmF<sub>3</sub> (температура плавления  $T_{nn} = 1304 \pm 10^{\circ}$ С [7], порог "замораживания" объемной диффузии составляет ~540°С) фазовое полиморфное преврашение находится в области 495°С [8], где объемная диффузия заторможена. Это вызывает разброс температур превращения по данным разных авторов на несколько десятков градусов [9]. В результате уверенно расположить морфотропный переход между PmF<sub>3</sub> и SmF<sub>3</sub> затруднительно.

Практическим значением проводимого исследования является получение концентрационной серии тисонитовых кристаллов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$ , рост которых длительное время тормозился соображениями о наличии у  $SmF_3$  деструктивного полиморфного  $\alpha \leftrightarrow \beta$ -превращения, что методически сделано впервые.

Особый интерес тисонитовые кристаллы  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$  (M = Sr, Ba;  $R - P3\Theta$ ) стали представлять недавно, после интенсификации работ по созданию новых фтор-ионных источников тока, способных по многим параметрам конкурировать с литий-ионными источниками тока [10–14].

Целью работы являются получение из расплава кристаллов тисонитовой фазы  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_y\text{F}_{3-y}$  и эвтектического композита состава 69SmF<sub>3</sub> × × 31SrF<sub>2</sub>, их характеризация методами рентгенофазового анализа (**РФА**) и оптической спектроскопии, исследование зависимостей фтор-ионной проводимости  $\sigma_{de}(y)$ , плотности  $\rho(y)$  и показателя преломления  $n_D(y)$  от состава.

# МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Выращивание кристаллов и получение эвтектического композита. Фазовая диаграмма системы  $SrF_2-SmF_3$  [15] показана на рис. 1. Эта система относится к эвтектическому типу с координатами эвтектики: температура 1312  $\pm$  10°C, состав 69  $\pm$ ± 2 мол. % SmF<sub>3</sub>. Процесс получения кристаллов флюоритовой фазы  $Sr_{1-x}Sm_xF_{2+x}$  (фаза **F** на рис. 1) и их комплексная аттестация приведены в [16, 17]. Добавление SrF<sub>2</sub> к SmF<sub>3</sub> приводит к образованию нестехиометрической фазы Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> с дефектной структурой типа тисонита (LaF<sub>3</sub>), в которой содержание SrF<sub>2</sub> изменяется в интервале 0-23 мол. % при эвтектической температуре (фаза Т на рис. 1). На кривых ликвидуса фазы Sm<sub>1-v</sub>Sr<sub>v</sub>F<sub>3-v</sub> наблюдается температурный максимум (1340 ± 10°С) для состава с 13 мол. % SrF<sub>2</sub> (мол. доля  $y \approx 0.13$ ), который превышает температуру плавления компонента  $SmF_3$  на ~35°C.

Для проведения ростовых экспериментов выбраны составы  $Sm_{1-\nu}Sr_{\nu}F_{3-\nu}$  с содержанием  $SrF_{2}$ в диапазоне y = 0 - 0.31. Выращивание кристаллов  $Sm_{1-\nu}Sr_{\nu}F_{3-\nu}$  и композита 69SmF<sub>3</sub> × 31SrF<sub>2</sub> осуществлялось методом направленной кристаллизации в двухзонной установке с резистивным нагревом и графитовым тепловым узлом в смешанной атмосфере высокочистых гелия и CF<sub>4</sub> (до 50 об. %). Исходными реактивами служили порошки SmF<sub>3</sub> (чистота 99.99 мас. %, ЛАНХИТ) и SrF<sub>2</sub> (чистота 99.995 мас. %, Sigma-Aldrich). Использовались многоячеистые графитовые тигли с затравочными каналами. Температурный градиент в ростовой зоне составлял ~80°С/см. Скорость опускания тигля ~3 мм/ч. Средняя скорость охлаждения кристаллов после роста составляла 100°С/ч. Потери на испарение не превышали 0.5-0.8 мас. %.

Рентенофазовый анализ выполняли на порошковом рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (излучение Cu $K_{\alpha}$ ). Регистрацию дифрактограмм проводили в диапазоне углов 20 от 10° до 100°. Идентификацию фаз осуществляли с использованием базы данных ICDD PDF-2 (2014). Уточнение параметров элементарной ячейки проводили методом Ритвельда с использованием программного обеспечения X'Pert HighScore Plus (PANanalytical, Нидерланды).

Образцы толщиной h = 2 мм для исследований вырезали из центральных участков кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  (0.03  $\leq y \leq$  0.31) и полировали. Образец с y = 0.02 имел размеры  $h = 1 \times 3 \times 3$  мм<sup>3</sup>.

Плотность кристаллов  $\rho$  измеряли методом гидростатического взвешивания в дистиллированной воде при комнатной температуре с точностью  $\Delta \rho = \pm 0.005 \text{ г/см}^3$ .

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 3 2019



**Рис.** 1. Фазовая диаграмма системы  $SrF_2-SmF_3$  (а). Показаны кристаллы, полученные из составов максимумов для флюоритовой (**F**) и тисонитовой (**T**) фаз. Внешний вид серии образцов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  и  $Sm_{0.995}Sr_{0.005}F_{2.9995}$  (б).

Показатели преломления  $n_D$  (длина волны  $\lambda = 0.589$  мкм) исследовали рефрактометрическим методом (иммерсионная жидкость  $\alpha$ -бромнафталин) при комнатной температуре при помощи рефрактометра ИРФ-454.

Спектры оптического пропускания кристаллов регистрировали при комнатной температуре с помощью спектрофотометра Cary 5000 (Agilent Technologies) и ИК фурье-спектрометра Nicolet Nexus 5700 (Thermo Scientific) в диапазоне длин волн  $\lambda = 0.2-15$  мкм.

Электрофизические измерения проводили на неориентированных образцах, так как величиной анизотропии проводимости кристаллов тисонитовых нестехиометрических фаз можно пренебречь [18, 19]. В качестве материала инертных электродов использовали графитовую пасту Dag-580 (Acheson Colloids). Электропроводность на постоянном токе  $\sigma_{dc}$  определяли методом импедансной спектроскопии. Методика электрофизических измерений приведена в [20]. Относительная погрешность измерений  $\sigma_{dc}$  составляла 5%.

Измерения комплексного импеданса  $Z^*(\omega)$  концентрационной серии кристаллов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$ при комнатной температуре (T = 293 K) выполняли в диапазонах частот  $5-5 \times 10^5$  Гц и сопротивлений  $1-10^7$  Ом (импедансметр Tesla BM-507) в вакууме ~1 Па. Для кристалла  $Sm_{0.97}Sr_{0.03}F_{2.97}$  и эвтектического композита  $69SmF_3 \times 31SrF_2$  проведены температурные исследования импеданса  $Z^*(\omega)$  в интервале 290–541 К.



**Рис. 2.** Дифрактограммы образцов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub>. Приведены положения рефлексов Брэгга для фаз указанных пространственных групп.

Наличие в спектрах импеданса блокирующего эффекта от инертных (графитовых) электродов при низких частотах указывает на ионный характер электропереноса в кристаллах. Для эвтектического композита  $69 \text{SmF}_3 \times 31 \text{SrF}_2$  найдена общая проводимость образца, ее разделение на объемно- и межкристаллитный вклады не проводилось.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Получены 14 кристаллических буль  $Sm_{1-\nu}Sr_{\nu}F_{3-\nu}$ диаметром 12 мм и длиной 25-35 мм с содержанием, равным  $0.005 \le y \le 0.31$  (рис. 1б). Кристаллы с  $0.03 \le y \le 0.21$  не имели трещин и объемных включений. Для образцов составов с  $0.005 \le y \le$ ≤0.02 прозрачная фаза наблюдалась только в нижней части буль и составляла менее 2% от общей длины. Для составов в диапазоне  $0.18 \le y \le$ ≤ 0.25 в верхней части кристалла наблюдалась полупрозрачная оттесненная фаза, а образец с составом v = 0.31 был двухфазным и визуально образцы полупрозрачным. Отметим, ЧТО  $Sm_{1-\nu}Sr_{\nu}F_{3-\nu}$  для  $0.005 \le y \le 0.02$  застревали в ячейках графитового тигля. Причиной такого «залипания» (механического застревания) кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  является полиморфный переход  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> (пр. гр. *Pnma*)  $\leftrightarrow \alpha$ -*l*-SmF<sub>3</sub> (пр. гр. *P* $\overline{3}c1$ ), сопровождающийся уменьшением плотности.

РФА кристаллов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  показал, что они являются однофазными во всем объеме для составов  $0.03 \le y \le 0.18$  (рис. 2). Кристаллические були  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  с  $0.005 \le y \le 0.02$  являются двухфазными. Непрозрачные верхние участки этих буль (рис. 1а) отвечают ромбической фазе  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> (пр. гр. *Pnma*), а прозрачные – тисонитовой фазе  $\alpha$ -*l*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (пр. гр. *P*3*c*1). Низкотемпературная фаза  $\alpha$ -*l*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> образуется при кристаллизации составов с  $0.005 \le y \le 0.08$ . Для составов с y > 0.08 наблюдаются переход из тисонитовой формы  $\alpha$ -*l*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (пр. гр. *P*3*c*1) в высотемпературную форму  $\alpha$ -*h*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (пр. гр. *P*6<sub>3</sub>/*mmc*) и ее стабилизация.

Полупрозрачная оттесняемая субстанция в верхней части образцов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  для  $0.18 \le y \le 0.25$  состоит из смеси "примесной" флюоритовой фазы  $\text{Sr}_{1-x}\text{Sm}_{x}\text{F}_{2+x}$  (пр. гр.  $Fm\overline{3}m$ ) с параметром элементарной ячейки a = 5.775(1) Å и ос-



**Рис. 3.** Концентрационная зависимость параметров решетки ( $\bigcirc$ ,  $\spadesuit$ ) и объемов элементарной ячейки ( $\blacksquare$ ) тисонитовой фазы Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>. Пунктир – аналитические зависимости *a*(*y*) и *c*(*y*) по данным [21].

новной тисонитовой фазы  $\alpha$ -*h*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>, что согласуется с полученным в [15] значением предельной растворимости SrF<sub>2</sub> в матрице SmF<sub>3</sub> ( $y \approx \approx 0.23$ ).

Образец с y = 0.31 представляет собой двухфазный во всем объеме эвтектический композит, состоящий из смеси нестехиометрических фаз с предельными составами для флюоритовой (пр. гр.  $Fm\overline{3}m$ , a = 5.774(1) Å) и тисонитовой (пр. гр.  $P6_3/mmc$ , a = 4.0419(1) и c = 7.1951(1) Å) структур.

На рис. 3 приведены концентрационные зависимости параметров решетки a(y), c(y) и объема элементарной ячейки V кристаллов нестехиометрической фазы Sm<sub>1 – v</sub>Sr<sub>v</sub>F<sub>3 – v</sub> Данные удовлетворительно совпадают с результатами [21]. Значения параметра c(y) слабо квадратично возрастают от 7.1323(1) до 7.1951(1) Å в диапазоне составов  $0.005 \le y \le 0.31$ . В области y = 0.08 - 0.10 отчетливо наблюдаются смена форм структуры типа тисонита и переход от "большой ячейки" (α-l- $Sm_{1-\nu}Sr_{\nu}F_{3-\nu}$ , пр. гр.  $P\overline{3}c1, Z=6$ ) к "малой ячейке" ( $\alpha$ -*h*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>, пр. гр. *P*6<sub>3</sub>/*mmc*, *Z* = 2). Наблюдаемый концентрационный структурный переход с изменением объема элементарной ячейки и пространственной группы симметрии характерен для тисонитовых нестехиометрических фаз  $R_{1-y}M_{y}F_{3-y}$  (R = La - Nd, M = Ca, Sr, Ba) [22, 23].

Результаты измерения плотности  $\rho(y)$  кристаллов тисонитовой фазы  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  приведены на рис. 4а. Зависимость  $\rho(y)$  имеет практически линейный (с погрешностью  $\Delta \rho = \pm 0.02$  г/см<sup>3</sup>) убывающий характер в диапазоне  $0.03 \le y \le 0.23$ . Данные по плотностям тисонитовой  $\alpha$ -*l*-SmF<sub>3</sub> и ром-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 3 2019



**Рис. 4.** Концентрационные зависимости плотности (а) и показателей преломления (б) для кристаллов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> при T = 293 К. Обозначения:  $\bigcirc$  – экспериментальные значения; ренттеновская плотность для  $\alpha$ -SmF<sub>3</sub> (**I**) и  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> (**O**) [24],  $\Delta$  – данные [25] для Sm<sub>0.87</sub>Sr<sub>0.13</sub>F<sub>2.87</sub>;  $\bigcirc$ , **O** – экспериментальные значения для  $n_0$  и  $n_e$  соответственно;  $\diamondsuit$ , **H** –  $n_0$  и  $n_e$  для Sm<sub>0.87</sub>Sr<sub>0.13</sub>F<sub>2.87</sub> для  $\lambda$  = 0.635 мкм [25];  $\square$ , **I**,  $\boxtimes$  – главные показатели преломления для  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> [26].

бической  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> модификаций [24] и кристалла Sm<sub>0.87</sub>Sr<sub>0.13</sub>F<sub>2.87</sub> [25] приведены для сравнения.

Зависимости показателей преломления  $n_D$  кристаллов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> от состава (0.03  $\leq y \leq$  0.25) показаны на рис. 46. Кристаллы являются одноосными и оптически отрицательными ( $n_o > n_e$ ). Значения  $n_o$  на длине волны  $\lambda = 0.589$  мкм монотонно уменьшаются в диапазоне от 1.601(1) до 1.569(1) в исследованном диапазоне составов *y*. Зависимости  $n_D(y)$  могут быть описаны полиномами второй степени, параметры которых указаны на рис. 46. Двулучепреломление  $\Delta n_D \sim 0.008$  и практически не зависит от состава кристаллов *y*. Как видно из рис. 46, оптические данные для кри-



**Рис. 5.** Спектры пропускания кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_y\text{F}_{3-y}$  для y = 0.13 (1), 0.18 (2) и кристалла  $\text{La}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{F}_3$ , выращенного в восстановительных условиях (3). Толщина образцов 2 мм.

сталла  $Sm_{0.87}Sr_{0.13}F_{2.87}$ , выращенного в [25] методом Чохральского, существенно отличаются от настоящих, что указывает, по-видимому, на ошибку в определении его химического состава. Для сравнения приведены значения главных показателей преломления кристалла  $\beta$ -SmF<sub>3</sub> [26].

Спектры оптического пропускания кристаллов Sm<sub>1-v</sub>Sr<sub>v</sub>F<sub>3-v</sub> показаны на рис. 5. Кристаллы прозрачны в ИК-диапазоне до 13 мкм. В спектрах наблюдаются переходы из основного <sup>6</sup>Н<sub>5/2</sub>-состояния на расположенные выше мультиплеты 4/5конфигурации Sm<sup>3+</sup>. Характерные для ионов  $Sm^{2+}$  полосы поглощения, связанные  $4f^5-4f5d^1$ переходами, расположены в видимой и УФ-областях спектра [27]. Для сравнения на рис. 5 (кривая 3) приведен спектр пропускания кристалла  $La_{0.99}Sm_{0.01}F_3$ , выращенного в восстановительной атмосфере. В спектре этого кристалла наблюдается поглощение в области  $\lambda < 0.7$  мкм, указывающее на наличие в нем доли восстановленных ионов Sm<sup>2+</sup>, чего не наблюдается для изучаемых кристаллов Sm<sub>1-v</sub>Sr<sub>v</sub>F<sub>3-v</sub>. Таким образом, в окислительно-восстановительных условиях выращивания кристаллов Sm<sub>1 – v</sub>Sr<sub>v</sub>F<sub>3 – v</sub> из расплава в графитовых тиглях, реализуемых в проводимых экспериментах, значимого восстановления ионов  $Sm^{3+}$  до состояния (2+) не происходит.

Концентрационная зависимость фтор-ионной проводимости кристаллов тисонитовой фазы  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  (0.02  $\leq y \leq$  0.25) имеет монотонно убывающий характер (рис. 6). Максимальная проводимость  $\sigma_{dc} = 1.6 \times 10^{-4}$  См/см обнаружена



**Рис. 6.** Концентрационная зависимость ионной проводимости  $\sigma_{dc}(y)$  для кристаллов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> (*1*–3) и композита 69SmF<sub>2</sub> × 31SrF<sub>2</sub> (*4*) при *T* = 293 K: *1*, *4* – данная работа, *2* – [6], *3* – [28]. Температурные зависимости ионной проводимости  $\sigma_{dc}(T)$  для кристаллов Sm<sub>0.97</sub>Sr<sub>0.03</sub>F<sub>2.97</sub> (*1*), Sm<sub>0.875</sub>Sr<sub>0.125</sub>F<sub>2.875</sub> [6] (*2*) и композита 69SmF<sub>2</sub> × 31SrF<sub>2</sub> (*3*) показаны на вставке.

для состава кристалла  $Sm_{0.98}Sr_{0.02}F_{2.98}$ . Его проводимость в ~3 раза ниже, чем у наиболее проводящего среди  $R_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  кристалла  $Ce_{0.97}Sr_{0.03}F_{2.97}$ [3, 5]. Проводимость эвтектического композита 69SmF<sub>3</sub> × 31SrF<sub>2</sub> равна  $\sigma_{dc} = 6 \times 10^{-8}$  См/см, что значительно (в 2.7 × 10<sup>3</sup> раз) ниже значения  $\sigma_{dc}$ кристалла Sm<sub>0.98</sub>Sr<sub>0.02</sub>F<sub>2.98</sub>. Для сравнения на рис. 6 приведены данные по проводимости кристаллов Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (y = 0.125 [6] и 0.13 [28]).

Температурные зависимости ионной проводимости  $\sigma_{dc}(T)$  для кристалла  $\mathrm{Sm}_{0.97}\mathrm{Sr}_{0.03}\mathrm{F}_{2.97}$  и эвтектического композита 69 $\mathrm{SmF}_2 \times 31\mathrm{SrF}_2$  в интервале температур 290—541 К показаны на вставке рис. 6 (кривые *1* и *3*). Зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  обрабатывали по уравнению Френкеля—Аррениуса:

$$\sigma_{dc}T = A \exp(-\Delta H_{\sigma}/kT), \qquad (1)$$

где A — предэкспоненциальный множитель проводимости,  $\Delta H_{\sigma}$  — энтальпия активации ионного транспорта, k — константа Больцмана, T — температура. Параметры уравнения Френкеля—Аррениуса составляют:  $A = 3.5 \times 10^3$  См К/см,  $\Delta H_{\sigma} = 0.30 \pm 0.03$  эВ для кристалла Sm<sub>0.97</sub>Sr<sub>0.03</sub>F<sub>2.97</sub> и  $A = 2.7 \times 10^6$  См К/см,  $\Delta H_{\sigma} = 0.65 \pm 0.02$  эВ для композита 69 SmF<sub>2</sub> × 31 SrF<sub>2</sub>.

Для сравнения на вставке рис. 6 (кривая 2) показана зависимость  $\sigma_{dc}(T)$  для кристалла конгруэнтно плавящегося состава Sm<sub>0.875</sub>Sr<sub>0.125</sub>F<sub>2.875</sub>, исследованная ранее [6] в широком интервале тем-



**Рис.** 7. Зависимости концентрации  $n_{mob}(y)$  (1) и подвижности  $\mu_{mob}(y)$  при T = 293 К (2) для кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_y\text{F}_{3-y}$  от содержания  $\text{SrF}_2$ .

ператур 173–1073 К. В этом интервале  $\sigma_{dc}$  возрастают от 2 × 10<sup>-12</sup> до 7 × 10<sup>-1</sup> См/см (на 11 порядков). При 573 К зависимость  $\sigma_{dc}(T)$  разделяется на два участка. Параметры уравнения Френкеля–Аррениуса составляют:  $A = 9.1 \times 10^5$  См К/см,  $\Delta H_{\sigma} = 0.53 \pm 0.01$  эВ при 173–573 К и  $A = 5.6 \times 10^4$  См К/см,  $\Delta H_{\sigma} = 0.39 \pm 0.02$  эВ при 573–1073 К.

Результаты исследования тисонитовых фаз  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$  в системах  $MF_2-RF_3$  (M = Ca, Sr, Ba) методом F<sup>19</sup> ЯМР [29–31] указывают на то, что ионный перенос в них происходит в анионной подрешетке. Механизм ионной проводимости в кристаллах  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$  связан с миграцией фторных вакансий  $V_F^+$ , кластеры дефектов не обнаружены [2–6, 28, 32–34].

Гетеровалентные замещения в катионной подрешетке  $Sm_{1-y}Sr_{y}F_{3-y}$  обусловливают появление в анионной подрешетке подвижных вакансий фтора:

$$\mathrm{Sm}^{3+} \to \mathrm{Sr}^{2+} + V_{\mathrm{F}}^{+}, \qquad (2)$$

где  $V_{\rm F}^+$  — ионный носитель заряда. Ионный транспорт в кристаллах Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> определяется характеристиками подвижных  $V_{\rm F}^+$ :

$$\sigma_{dc} = q n_{mob} \mu_{mob}, \qquad (3)$$

где q,  $n_{mob}$  и  $\mu_{mob}$  — заряд, концентрация и подвижность вакансий  $V_{\rm F}^+$ . Концентрация носителей заряда в ионных проводниках  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$  не зависит от температуры и определяется механизмом образования "примесных" вакансий (2). С учетом структурных данных рассчитана концентрация носителей:

$$n_{mob} = 2Zy/(\sqrt{3a^2c}), \qquad (4)$$

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 3 2019

и далее из (3) и (4) вычислена их подвижность  $\mu_{mob}$ .

Рассчитанные значения  $n_{mob}$  и  $\mu_{mob}$  для кристаллов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> приведены на рис. 7. Концентрация носителей заряда при T = 293 К для наиболее проводящего кристалла Sm<sub>0.98</sub>Sr<sub>0.02</sub>F<sub>2.98</sub> составляет  $n_{mob} = 4.0 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> при подвижности  $\mu_{mob} = 2.5 \times 10^{-6}$  см<sup>2</sup>/Вс. С ростом содержания SrF<sub>2</sub> поведение зависимостей  $n_{mob}(y)$  и  $\mu_{mob}(y)$  разнонаправлено. С увеличением у от 0.02 до 0.25 значения  $n_{mob}$  возрастают в 12 раз, в то время как значения  $\mu_{mob}$  падают в 2 × 10<sup>4</sup> раз. Снижение величины  $\sigma_{dc}$  кристаллов Sm<sub>1 – y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3 – y</sub> в интервале изученных составов  $0.02 \le y \le 0.25$  вызвано уменьшением подвижности носителей заряда вследствие ионногных взаимодействий между ними.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые из расплава методом Бриджмена получена серия кристаллов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$  (0 <  $y \le \le 0.31$ ). Показано, что полиморфное  $\alpha \leftrightarrow \beta$ -превращение в SmF<sub>3</sub> не позволяет получить объемные образцы тисонитовой фазы  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$ (тип LaF<sub>3</sub>) для составов y < 0.02. В реализованных условиях выращивания кристаллов  $Sm_{1-y}Sr_yF_{3-y}$ из расплава в графитовом тигле во фторирующей атмосфере (CF<sub>4</sub>) не происходит существенного восстановления ионов Sm<sup>3+</sup> до состояния Sm<sup>2+</sup>.

Низкотемпературная тисонитовая фаза  $\alpha$ -*l*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (пр. гр.  $P\overline{3}c1$ ) образуется для кристаллов Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> с 0.005  $\leq y \leq$  0.08. Начиная с содержания y > 0.08 рентгенографически наблюдается стабилизация высокотемпературной тисонитовой фазы  $\alpha$ -*h*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (пр. гр.  $P6_3/mmc$ ). Образец с y = 0.31 является двухфазным эвтектическим композитом, состоящим из смеси нестехиометрических фаз с насыщенными при эвтектической температуре составами для флюоритовой (Sr<sub>1-x</sub>Sm<sub>x</sub>F<sub>2+x</sub>) и тисонитовой (Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>) структур.

Установлено, что концентрационный переход в тисонитовых модификациях  $\alpha$ -*l*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>  $\leftrightarrow \alpha$ -*h*-Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> при y = 0.08-0.1 не проявляется на концентрационных зависимостях плотности  $\rho(y)$ , показателя преломления  $n_D(y)$  и проводимости  $\sigma_{dc}(y)$ . Для нестехиометрической тисонитовой фазы Sm<sub>1-y</sub>Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> (0.03  $\leq y \leq 0.25$ ) значения плотности  $\rho(y)$  и показателя преломления  $n_D(y)$  монотонно уменьшаются в диапазоне составов  $0.03 \leq y \leq 0.25$ .

Исследована концентрационная зависимость ионной проводимости кристаллов нестехиометрической фазы  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  в интервале составов  $0.02 \le y \le 0.25$  и композита  $69\text{SmF}_2 \times 31\text{SrF}_2$ .

Проводимость при комнатной температуре эвтектического композита  $69 \text{SmF}_2 \times 31 \text{SrF}_2$  равна  $\sigma_{dc} = 6 \times 10^{-8} \text{ См/см}$ , а для наиболее проводящего кристалла твердого раствора состава  $\text{Sm}_{0.98}\text{Sr}_{0.02}\text{F}_{2.98}$  (y = 0.02)  $\sigma_{dc} = 1.6 \times 10^{-4} \text{ Cm/cm}$ .

В рамках модели прыжковой проводимости для кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$  рассчитаны концентрация и подвижность носителей заряда (вакансий фтора), которые составляют  $n_{mob} = 4.0 \times 10^{20} \text{ см}^{-3}$  и  $\mu_{mob} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ см}^{2}/\text{Bc}$  (T = 293 K) для кристалла  $\text{Sm}_{0.98}\text{Sr}_{0.02}\text{F}_{2.98}$ . Антибатное поведение зависимостей  $n_{mob}(y)$  и  $\mu_{mob}(y)$  определяет снижение величины  $\sigma_{dc}$  кристаллов  $\text{Sm}_{1-y}\text{Sr}_{y}\text{F}_{3-y}$ с ростом содержания y.

Авторы выражают благодарность Н.А. Ивановской, Б.В. Набатову и Т.Б. Косовой за помощь в получении экспериментальных данных.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 16-03-00707, 17-00-00118) в части выращивания кристаллических образцов и Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию в части исследования характеристик кристаллов с использованием оборудования Центра коллективного пользования Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Kirhenbaum A.D., Cahill J.A.* // J. Inorg. Nuclear Chem. 1960. V. 14. № 1–2. P. 148.
- 2. Сорокин Н.И., Фоминых М.В., Кривандина Е.А. и др. // Кристаллография. 1996. Т. 41. № 2. С. 310.
- 3. *Сорокин Н.И., Соболев Б.П.* // Электрохимия. 2007. Т. 43. № 4. С. 420.
- Сорокин Н.И., Соболев Б.П. // Кристаллография. 1994. Т. 39. № 5. С. 889.
- 5. *Соболев Б.П., Сорокин Н.И.* // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 6. С. 891.
- Sobolev B.P., Sorokin N.I., Bolotina N.B. // Photonic & Electronic Properties of Fluoride Materials / Eds. Tressaud A., Poeppelmeier K. Amsterdam: Elsevier, 2016. P. 465.
- Greis O., Cader M.S.R. // Thermochim. Acta. 1985. V. 87. P. 145.
- Rotereau K., Daniely Ph., Desert A., Gesland J.Y. // J. Phys. Cond. Matter. 1998. V. 10. № 6. P. 1431.
- 9. *Sobolev B.P.* The Rare Earth Trifluorides. The High Temperature Chemistry of Rare Earth Trifluorides, Institute of Crystallography, Moscow, and Institut d'Es-

tudis Catalans, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Spain, 2000. 520 p.

- 10. *Потанин А.А.* // Журн. Рос. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева. 2001. Т. XLV. № 5-6. С. 58.
- Anji Reddy M., Fichtner M. // J. Mater. Chem. 2011. V. 21. P. 17059.
- Rongeat C., Anji Reddy M., Witter R., Fichtner M. // J. Phys. Chem. 2013. V. 117. P. 4943.
- 13. Gschwind F., Rodriguez-Garsia G., Sandbeck D.J.S. et al. // J. Fluor. Chem. 2016. V. 182. P. 76.
- 14. *Dieudonne B., Chable J., Mauvy F. et al.* // J. Phys. Chem. C. 2015. V. 119. P. 25170.
- 15. *Sobolev B.P., Seiranian K.B.* // J. Solid State Chem. 1981. V. 39. № 3. P. 337.
- 16. Соболев Б.П., Каримов Д.Н., Сульянов С.Н. и др. // Кристаллография. 2009. Т. 54. № 1. С. 129.
- 17. Сорокин Н.И., Каримов Д.Н., Сульянова Е.А. и др. // Кристаллография. 2010. Т. 55. № 4. С. 708.
- Roos A., Aalders A.F., Schoonman J. et al. // Solid State Ionics. 1983. V. 9–10. P. 571.
- 19. *Сорокин Н.И., Соболев Б.П.* // Электрохимия. 2007. Т. 43. № 4. С. 420.
- Иванов-Шиц А.К., Сорокин Н.И., Федоров П.П., Соболев Б.П. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 6. С. 1748.
- Соболев Б.П., Александров В.Б., Федоров П.П. и др. // Кристаллография. 1976. Т. 21. № 1. С. 95.
- Болотина Н.Б., Черная Т.С., Калюканов А.И. и др. // Кристаллография. 2015. Т. 60. № 3. С. 391.
- 23. *Хрыкина О.Н., Сорокин Н.И., Верин И.А. и др. //* Кристаллография. 2017. Т. 62. № 4. С. 559.
- 24. Бацанова Л.Р. // Успехи химии. 1971. Т. 40. № 6. С. 945.
- Ананьева Г.В., Баранова Е.Н., Заржицкая М.Н. и др. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1980. Т. 16. № 1. С. 68.
- Staritzky E., Asprey L B. // Anal. Chem. 1957. V. 29. № 5. P. 855.
- 27. Раджабов Е.А., Козловский В.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2015. Т. 79. № 2. С. 275.
- Мурин И.В., Глумов О.В., Подколзина И.Г. и др. // Журн. прикл. химии. 1982. Т. 55. № 2. С. 300.
- Лившиц А.И., Бузник В.М., Федоров П.П., Соболев Б.П. // Неорган. материалы. 1982. Т. 18. № 1. С. 135.
- Aalders A.F., Polman A., Arts A.F.M., de Wijn H.W. // Solid State Ionics. 1983. V. 9–10. P. 539.
- Denecke M.A., Gunser W., Privalov A.V., Murin I.V. // Solid State Ionics. 1992. V. 52. P. 327.
- 32. Takahashi T., Iwahara H., Ishikawa T. // J. Electrochem. Soc. 1977. V. 124. № 2. P. 280.
- 33. *Мурин И.В., Глумов О.В., Амелин Ю.В. //* Журн. прикл. химии. 1980. Т. 53. № 7. С. 1474.
- Roos A., van de Pol F.C.M., Keim R., Schoonman J. // Solid State Ionics. 1984. V. 13. P. 191.